

Документ подписан простой электронной подписью

Информация о владельце:

ФИО: Косенок Сергей Михайлович

Должность: ректор

Дата подписания: 06.06.2024 14:47:25

Уникальный программный ключ:

3ab685eaa1e61674b5474998099d3d6bfdcf838

**Тестовое задание для диагностического тестирования по дисциплине
ЭЛЕКТРОНИКА, 4 семестр**

Код направления подготовки	11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи
Направленность (профиль)	Корпоративные инфокоммуникационные системы и сети
Форма обучения	очная
Кафедра-разработчик	Кафедра радиоэлектроники и электроэнергетики
Выпускающая кафедра	Кафедра радиоэлектроники и электроэнергетики

Проверяемая компетенция	Задание	Варианты ответов	Тип сложности вопроса
1	2	3	4
ОПК-1.4	1. Внешнее напряжение создаёт встречное поле внутреннему полю перехода и является ускоряющим для основных носителей заряда при (выберите правильный вариант ответа)	1. прямом смещении перехода 2. обратном смещении перехода 3. нагревании полупроводника 4. охлаждении полупроводника	Высокий (множественный выбор)
ПК-1.1	2. Выключение тиристора в цепи переменного тока происходит (выберите все правильные варианты ответов из предложенных)	1. когда ток через тиристор обращается в ноль 2. при подаче сигнала на управляющий электрод 3. когда ток через тиристор становится меньше тока отпускания 4. когда ток через тиристор становится больше тока отпускания	Высокий (множественный выбор)
ОПК-4.1	3. Для биполярного транзистора примеси в отдельных областях соотносятся следующим образом: (выберите правильный вариант ответа)	1. $N_э > N_к > N_б$ 2. $N_к > N_э > N_б$ 3. $N_к > N_б > N_э$ 4. $N_б > N_к > N_э$ 5. $N_б > N_э > N_к$	Высокий (множественный выбор)

ОПК-4.2	4. Коэффициент передачи тока эмиттера биполярного транзистора это	1. отношение тока эмиттера к току базы	Высокий (множественный выбор)
---------	---	--	-------------------------------

	(выберите правильный вариант ответа)	<ul style="list-style-type: none"> 2. отношение тока эмиттера к току коллектора 3. отношение тока коллектора к току эмиттера 4. отношение тока коллектора к току базы 5. отношение тока базы к току коллектора 	
ОПК-4.4	5. В режиме обеднения может работать (выберите правильный вариант ответа)	<ul style="list-style-type: none"> 1. биполярный транзистор 2. полевой транзистор с управляющим р-п переходом 3. полевой транзистор со встроенным каналом 4. полевой транзистор с индуцированным каналом 5. тиристор 	Высокий (множественный выбор)
ОПК-2.1	6. Полупроводники р-типа получают путем введения в собственный 4-х валентный полупроводник атомов (выберите правильный вариант ответа)	<ul style="list-style-type: none"> 1. 3-х валентной примеси 2. 5-и валентной примеси 3. 4-х валентной примеси 4. 2-х валентной примеси 5. 6-х валентной примеси 	Средний (только один ответ)
ОПК-2.2	7. В полупроводнике р-типа основными свободными носителями заряда являются электроны В полупроводнике р-типа основными свободными носителями заряда являются дырки (исключите лишнее)	Лишнее:	Средний (верно/неверно)
ОПК-2.3	8. Процесс притяжения электрона и дырки называется рекомбинацией Процесс взаимного исчезновения электрона и дырки называется рекомбинацией (исключите лишнее)	Лишнее:	Средний (верно-неверно)
ОПК-2.4	9. Статистический смысл уровня Ферми — при [1] его заселенность (вероятность наличия частиц с такой энергией) равна [2] (дополните, впишите недостающие слова или словосочетания на месте пропуска)	<ul style="list-style-type: none"> 1. любой температуре 2. 0,5 3. любом напряжении 4. 1 5. любом воздействии 6. 0 	Средний (выбор пропущенных слов)
ОПК-2.5	10. Область полупроводника с большей концентрацией примеси называется [1], с меньшей называется [2] (дополните, впишите недостающие слова на месте пропуска)	<ul style="list-style-type: none"> 1. эмиттером 2. базой 3. основной 4. неосновной 	Средний (выбор пропущенных слов)
ОПК-2.6	11. Разность потенциалов на границах р-п перехода называется [1] или [2] барьером	<ul style="list-style-type: none"> 1. контактной разностью потенциалов 2. потенциальным 3. напряжением 4. энергетическим 	Средний (выбор пропущенных слов)

	(дополните, впишите недостающие слова или словосочетания на месте пропуска)	5. падением напряжения 6. зарядовым	
ОПК-2.7	12. При повышении температуры прямой ток [1], обратный ток [2] (дополните, впишите недостающие слова на месте пропуска)	1. растёт 2. растёт 3. не изменяется 4. уменьшается 5. не изменяется 6. уменьшается	Средний выбор пропущенных слов
ОПК-1.4	13. Нагрузочная линия, определяющая режим работы параметрического стабилизатора напряжения, проводится из координаты [1] на горизонтальной оси до точки [2] на вертикальной оси (дополните, впишите недостающие слова или словосочетания на месте пропуска)	1. входного напряжения 2. $U_{вх}/R_b$ 3. выходного тока 4. $I_{вх}/R_b$ 5. выходного напряжения 6. $I_{вх} \cdot R_b$	Средний (выбор пропущенных слов)
ПК-2.15	14. Значение коэффициента передачи тока эмиттера лежит в пределах [1], а значение коэффициента передачи тока базы [2] (дополните, впишите недостающие числа на месте пропуска)	1. 0.9-0.99 2. 10-150 3. 0.9-1.1 4. 1-1.2	Средний (выбор пропущенных слов)
ПК-2.16	15. Каждый из переходов транзистора может быть смещен в прямом или обратном направлении, чему соответствуют четыре режима работы транзистора: 1) [1] – оба p – n перехода смещены в обратном направлении, токи через транзистор практически отсутствуют; 2) [2] – на оба перехода подано прямое смещение, через транзистор проходят достаточно большие токи; 3) [3] – на эмиттерный переход подано прямое смещение, на коллекторный – обратное; 4) [4] - на эмиттерный переход подано обратное смещение, на коллекторный – прямое. (дополните, впишите недостающие словосочетания на месте пропуска)	1. режим отсечки 2. режим насыщения 3. активный режим 4. инверсный режим 5. рабочий режим 6. статический режим	Средний (выбор пропущенных слов)
ПК-2.17 ПК-3.2	16. Ширина запрещённой зоны - это [1], которую должен приобрести электрон, чтобы разорвать [2] и стать свободным (дополните, впишите недостающие слова или словосочетания на месте пропуска)	1. энергия 2. ковалентную связь 3. работа 4. ячейку 5. заряд 6. атом	Низкий (выбор пропущенных слов)

ПК-4.14 ПК-5.4	17. Подвижность носителей заряда — коэффициент пропорциональности между [1] и [2] (дополните, впишите недостающие слова или словосочетания на месте пропуска)	1. дрейфовой скоростью носителей 2. приложенным внешним электрическим полем 3. напряжением 4. температурой 5. током 6. градиентом температур	Низкий (выбор пропущенных слов)
ПК-5.10	18. Крутизна вольт-амперной характеристики диода определяется [1] к вольт-амперной характеристике (дополните, впишите недостающее слово или словосочетание на месте пропуска)	1. наклоном касательной 2. перпендикуляром 3. проекцией 4. секущей	Низкий (выбор пропущенных слов)
ПК-5.11 ПК-5.12	19. Статическое сопротивление диода характеризует его [1] (дополните, впишите недостающее слово или словосочетание на месте пропуска)	1. сопротивление постоянному току 2. сопротивление переменному току 3. ёмкость 4. индуктивность	Низкий (выбор пропущенных слов)
ОПК-2.8	20. Динамическое сопротивление диода характеризует его [1] (дополните, впишите недостающее слово на месте пропуска)	1. сопротивление переменному току 2. сопротивление постоянному току 3. ёмкость 4. индуктивность	Низкий (выбор пропущенных слов)